

シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ
SILICON PNP EPITAXIAL MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

2SA679, 2SA680

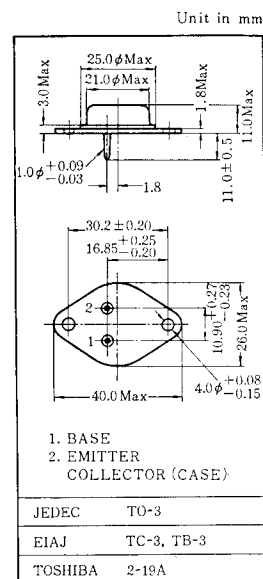
○低周波電力増幅用

○ Audio Power Amplifier Applications

- コレクタ損失が大きい: $P_C=100W$ ($T_C=25^\circ C$)
- 高耐圧です: $V_{CE0}=-120V$ (2SA679)
 $V_{CE0}=-100V$ (2SA680)
- 2SC1079, 2SC1080のコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC1079 and 2SC1080.

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic		Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	2SA679	V_{CBO}	−120	V
	2SA680		−100	
コレクタ・エミッタ 間電圧	2SA679	V_{CEO}	−120	V
	2SA680		−100	
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	− 5	V
コレクタ電流		I_C	−12	A
エミッタ電流		I_E	12	A
コレクタ損失 (T _C =25°C)		P _C	100	W
接合温度		T _J	150	°C
保存温度		T _{stg}	−65~150	°C



アクセサリはAC73を適用
MOUNTING KIT NO. AC73

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ C$)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-50V, I_E=0$	—	—	-100	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V, I_C=0$	—	—	-100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SA679	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=-100mA, I_B=0$	-120	—	V
	2SA680			-100	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	2SA679	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-10mA, I_C=0$	- 5	—	V
	2SA680			- 5	—	
直流電流増幅率	(Note) $h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	40	—	140	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-7A$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-10A, I_B=-1A$	—	—	-3.0	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5V, I_C=-10A$	—	—	-2.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	900	—	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA679 and 2SA680 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA679—R 2SA680—R	40	80
2SA679—Y 2SA680—Y	70	140

